



Universität Stuttgart



Institut für  
Robuste  
Leistungshalbleitersysteme

# Fachpraktikum (Bachelor)

## 6G HARDWARELABOR - DESIGN UND IMPLEMENTIERUNG EINES HF TRANSCEIVERS

---

### Versuch 2: Auslegung eines HF-Verstärkers

---

**Protokollführer**

Lukas Müller

Erik Zimmermann

Farhad Valizada

**Betreuer**

Simon Haussmann

**Eingereicht**

May 18, 2025

# Inhaltsverzeichnis

<b>Abkürzungsverzeichnis</b>	<b>3</b>
<b>1 Einleitung(Farhad)</b>	<b>4</b>
1.1 Ziel des Versuchs . . . . .	4
1.2 Relevanz und Anwendungsbereiche von HF-Verstärkern . . . . .	4
<b>2 Theoretische Grundlagen(Lukass)</b>	<b>5</b>
2.1 Funktion eines HF-Verstärkers . . . . .	5
2.2 Arbeitspunkteinstellung . . . . .	5
2.3 Bedeutung der S-Parameter . . . . .	5
2.4 (rolle kopplungskodensator) . . . . .	5
<b>3 HF-Simulation(Charhad)</b>	<b>6</b>
3.1 Inbetriebnahme von Keysight Advanced Design System (ADS) . . . . .	6
3.1.1 Installation von ADS . . . . .	6
3.1.2 Erstellen eines neuen Projekts . . . . .	6
3.1.3 Vertrautmachen mit der Benutzeroberfläche . . . . .	6
3.2 Analyse des Datenblattes zu Transistor BFR181W . . . . .	7
3.3 DC-Simulation . . . . .	7
3.3.1 Dimensionierung des Kollektorwiderstandes . . . . .	8
3.3.2 Dimensionierung des Basis-Spannungsteilers . . . . .	9
3.4 S-Parameter-Simulation . . . . .	10
3.5 Fazit . . . . .	11
<b>4 Technische Umsetzung(Erik)</b>	<b>13</b>
4.1 Platinen Aufbau . . . . .	13
4.2 DC-Pegel Verifizieren . . . . .	13
4.3 Kalibrierung . . . . .	13
4.4 Vergleich zur Simulation . . . . .	13
<b>5 Diskussion der Ergebnisse(GangBang)</b>	<b>15</b>
5.1 Vergleich von Theorie und Praxis . . . . .	15
5.2 Erklärung von Abweichungen . . . . .	15
<b>6 Fazit(Jeder)</b>	<b>16</b>
6.1 Zusammenfassung der wichtigsten Erkenntnisse . . . . .	16
6.2 Reflexion und mögliche Verbesserungen . . . . .	16
6.3 Eigene Reflexion . . . . .	16

6.3.1	Erik . . . . .	16
6.3.2	Farhad . . . . .	16
6.3.3	Lukas . . . . .	16
<b>Literaturverzeichnis</b>		<b>17</b>

# Abkürzungsverzeichnis

<b>ADS</b>	Advanced Design System
<b>HF</b>	Hochfrequenz
<b>6G</b>	Sixth Generation
<b>SMA</b>	SubMiniature version A
<b>PCB</b>	Printed Circuit Board

# Kapitel 1

## Einleitung(Farhad)

### 1.1 Ziel des Versuchs

Ziel des Versuches ist es, einen HF-Verstärker zu simulieren und dessen Eigenschaften zu analysieren. Dabei wird ein BJT-Transistor verwendet, um die Verstärkung des Signals zu erhöhen. Der Versuch umfasst die Analyse der Eigenschaften des vorliegenden Transistors der Reihe BFR181W, die Berechnung der Widerstände zur Anpassung des Arbeitspunktes, um eine optimale Verstärkung zu erzielen sowie die Durchführung einer S-Parameter-Simulation zur Überprüfung der Verstärkung und Stabilität des Verstärkers.

### 1.2 Relevanz und Anwendungsbereiche von HF-Verstärkern

Ein HF-Verstärker ist ein elektronisches Gerät, das Hochfrequenzsignale verstärkt. Diese Signale sind typischerweise im Frequenzbereich von 3 kHz bis 300 GHz ausgelegt und finden Anwendung in verschiedenen Bereichen wie Kommunikationstechnik, Radartechnologie, Satellitenkommunikation sowie in der Medizintechnik. HF-Verstärker sind entscheidend für die Signalübertragung und -verarbeitung in modernen Kommunikationssystemen. Sie werden eingesetzt, um schwache Signale zu verstärken, die von Antennen empfangen werden, und um sicherzustellen, dass die Signale über große Entfernungen übertragen werden können.

In unserem Versuch ist es von einer großen Bedeutung, die Eigenschaften des BJT-Transistors zu analysieren und die Widerstände so zu dimensionieren, dass ein stabiler Arbeitspunkt erreicht wird, damit bei späteren Versuchen eine Übertragung einer Bilddatei bei einer Frequenz von 1,25 GHz möglich ist.

## Kapitel 2

# Theoretische Grundlagen(Lukass)

### 2.1 Funktion eines HF-Verstärkers

Ein Verstärker ist ein elektronisches Gerät, mit mindestens einem aktiven Bauelement wie zum Beispiel einem Transistor. Das Ziel eines Verstärkers ist dass, das Ausgangssignal größer als das Eingangssignal ist. Da hierbei dem Signal Leistung hinzugefügt wird muss ein Verstärker eine eigene Energie Quelle haben.

Besonders in der Hochfrequenztechnik (HF) spielt der Verstärker eine wichtige Rolle. Soll zum Beispiel mithilfe einer Antenna noch in weiter Entfernung ein Signal gemessen werden muss dies zuerst verstärkt werden.

Normalerweise werden im Hochfrequenzbereich Frequenzen von 10 kHz bis 100.000 MHz verstärkt.

### 2.2 Arbeitspunkteinstellung

### 2.3 Bedeutung der S-Parameter

### 2.4 (Rolle Kopplungskondensator)

blabla

## Kapitel 3

# HF-Simulation(Charhad)

### 3.1 Inbetriebnahme von Keysight Advanced Design System (ADS)

#### 3.1.1 Installation von ADS

Die Software Advanced Design System ([ADS](#)) dient zur Simulation von Schaltungen verschiedener Komplexitätsgrade. In diesem Versuch wird die Software verwendet, um eine Hochfrequenzschaltung zu simulieren und zu analysieren. Die Software bietet eine Vielzahl von Funktionen, darunter die Möglichkeit, Schaltungen zu entwerfen, S-Parameter zu simulieren und verschiedene Analysewerkzeuge zu verwenden.

#### 3.1.2 Erstellen eines neuen Projekts

Die Software ist auf den Rechnern im Labor bereits installiert gewesen. Nach dem Start der Software wird ein neues Projekt aus den bereits zur Verfügung stehenden Workspaces erstellt. Diese sind auf der ILIAS-Seite des Praktikums in dem Dateiarchiv `TransmitterAmpDesign_2024.zip` hinterlegt. Die Datei wird entpackt und in der Software geöffnet. Außerdem werden die benötigten Bibliotheken aus dem Dateiarchiv `Infineon-RFTransistor-Keysight ADS Design Kit-SM-v02_10-EN.zip` geladen, diese stehen ebenfalls auf der ILIAS-Seite zur Verfügung.

#### 3.1.3 Vertrautmachen mit der Benutzeroberfläche

Schließlich werden die Tutorials 1 und 2 von [ADS](#) durchgearbeitet, um sich mit der Benutzeroberfläche und den grundlegenden Funktionen der Software vertraut zu machen.

Am Anfang der Schaltungsanalyse wird das Schema `TX_Amp_Bias.dds` geöffnet. Diese ist in der Abbildung 3.1 zu sehen.

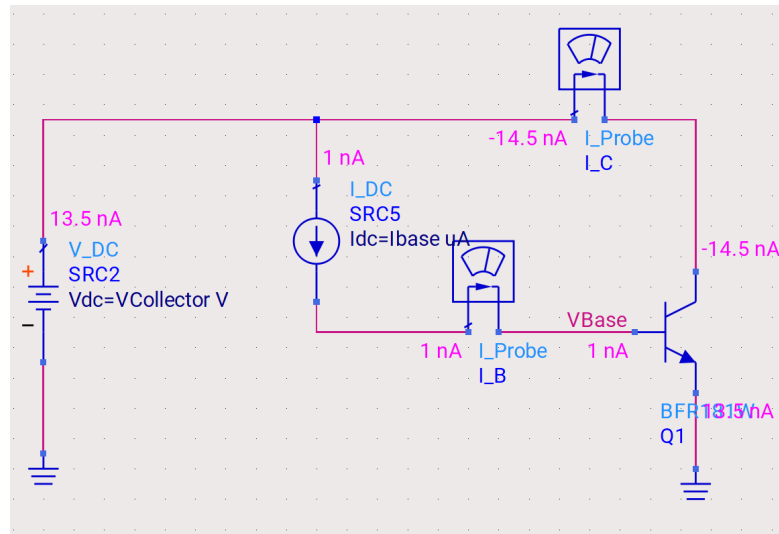


ABBILDUNG 3.1: Schaltbild der Schaltung `TX_Amp_Bias.dds` in ADS.

### 3.2 Analyse des Datenblattes zu Transistor BFR181W

Um die Schaltung zu simulieren, wird der Transistor BFR181W verwendet. Um die genauen Parameter des Transistors zu kennen, wird das Datenblatt des Transistors analysiert. Dieses steht auch auf der ILIAS-Seite des Praktikums zur Verfügung.

Die Tabelle “Maximum Ratings at  $T_A = 25^\circ\text{C}$ , unless otherwise specified” unten links auf Seite 1 des Dokuments zeigt, dass der maximal zulässige Kollektorstrom  $I_{C,\text{max}}$  20 mA beträgt.

### 3.3 DC-Simulation

Im folgendem wird eine DC-Simulation der später aufzubauenden Schaltung durchgeführt. Außerdem werden die Arbeitspunkte optimal durch die Anpassung der Widerstandswerte eingestellt. Die DC-Simulation wird in ADS durchgeführt, um die DC-Pegel der Schaltung zu überprüfen.



### 3.3.1 Dimensionierung des Kollektorwiderstandes

Folgende Spannungswerte werden angenommen:

- $U_{CC} = 4.8 \text{ V}$
- $U_{BE} = 0.77 \text{ V}$

Zuerst wird der Kollektorwiderstand  $R_5$  passend gewählt, sodass der Kollektorstrom  $I_C$  auf 75 % des maximal zulässigen Kollektorstroms  $I_{C,\max}$  gesetzt wird. Dies geschieht, indem der Widerstandswert  $R_5$  so gewählt wird, dass der Kollektorstrom  $I_C$  15 mA beträgt. Der Widerstandswert  $R_5$  wird mit folgender Formel berechnet:

$$R_5 = \frac{U_{CC} - U_{CE}}{I_C} = \frac{4.8 \text{ V}}{15 \text{ mA}} = 320 \Omega \quad (3.1)$$

Bei der Verwendung der E12-Reihe wird eine Faustregel verwendet, nach der man die Widerstandswerte auf die nächstgelegene E12-Reihe aufrundet. Somit beträgt der errechnete Widerstandswert von  $R_5$  330  $\Omega$ . Dadurch wird der in den Kollektor eingehende Strom beschränkt, was eine Überlastung des Transistors im Dauerbetrieb vorbeugt. Bei der Wahl eines niedrigeren Widerstandswertes würde der Kollektorstrom  $I_C$  den maximalen Kollektorstrom  $I_{C,\max}$  überschreiten, was zu einer Überlastung des Transistors führen würde.

Dieses Ergebnis lässt sich anhand der Simulation in [ADS](#) verifizieren. Es wird ein Sweep des Kollektorwiderstandes  $R_5$  in der Spanne von 100  $\Omega$  bis 4,7 k $\Omega$  durchgeführt. Es ergibt sich der folgende Verlauf des Kollektorstroms  $I_C$  in Abhängigkeit des Kollektorwiderstandes  $R_5$ :

## Einstellung Arbeitspunkt

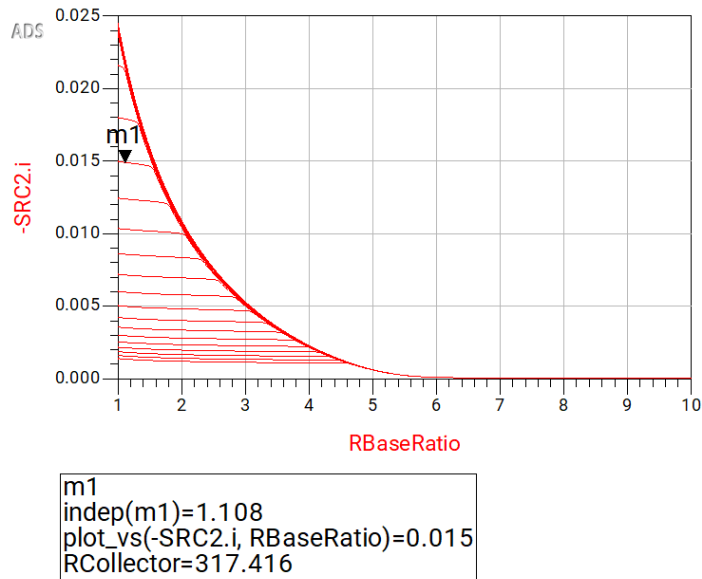


ABBILDUNG 3.2: Verlauf des Kollektorstroms  $I_C$  in Abhängigkeit des Kollektorwiderstandes  $R_5$ .

Aus der Abbildung 3.2 ist zu erkennen, dass der Kollektorstrom  $I_C$  mit steigendem Kollektorwiderstand  $R_5$  abnimmt. Mit dem Marker m1 wird außerdem gezeigt, dass der Kollektorstrom  $I_C$  bei einem Widerstandswert von 317,416  $\Omega$  einen Wert von 15 mA erreicht. Es wird der nächstgrößere Widerstandswert der E12-Reihe gewählt, also 330  $\Omega$ . Die Ergebnisse der Rechnung wurden also somit bestätigt.

### 3.3.2 Dimensionierung des Basis-Spannungsteilers

Um einen Arbeitspunkt mit  $I_C \approx 10$  mA zu erreichen, wird der Basis-Spannungsteiler dimensioniert. Die Basis-Emitter-Spannung beträgt  $U_{BE} \approx 0,7$  V. Der Emitterwiderstand wird hier vernachlässigt.

Der Basisstrom berechnet sich zu:

$$I_B = \frac{I_C}{\beta} \quad (3.2)$$

Für einen typischen Verstärkungsfaktor  $\beta = 100$  ergibt sich:

$$I_B = \frac{10 \text{ mA}}{100} = 0,1 \text{ mA} = 100 \mu\text{A} \quad (3.3)$$

Der Querstrom des Spannungsteilers  $I_Q$  sollte mindestens das 10-fache des Basisstroms betragen:

$$I_Q = 10 \cdot I_B = 1,0 \text{ mA} \quad (3.4)$$

Die Basisspannung  $U_B$  ergibt sich zu:

$$U_B = U_{BE} + U_E \approx 0,77 \text{ V} \quad (3.5)$$

Angenommen, die Betriebsspannung ist  $U_{CC} = 4,8 \text{ V}$ , ergibt sich für die Widerstände  $R_4$  (oben) und  $R_3$  (unten):

$$R_3 = \frac{U_B}{I_Q} = \frac{0,77 \text{ V}}{1,0 \text{ mA}} = 0,77 \text{ k}\Omega \quad (3.6)$$

$$R_4 = \frac{U_{CC} - U_B}{I_Q} = \frac{4,8 \text{ V} - 0,77 \text{ V}}{1,0 \text{ mA}} = 4,03 \text{ k}\Omega \quad (3.7)$$

Nach der Berechnung ergibt sich für  $R_3$  ein Wert von  $0,77 \text{ k}\Omega$ . In der praktischen Simulation mit ADS zeigte sich jedoch, dass mit diesem Wert ein negatives Gain bei der S-Parameter-Simulation auftritt. Daher wird  $R_3$  nach der E12-Reihe auf  $1,0 \text{ k}\Omega$  erhöht, um einen stabilen Arbeitspunkt und ein positives Verstärkungsverhalten zu gewährleisten.

Mit der E12-Reihe werden gewählt:

$$R_3 = 1,0 \text{ k}\Omega$$


$$R_4 = 4,7 \text{ k}\Omega$$

Damit ist der Spannungsteiler dimensioniert, sodass im Arbeitspunkt ein Kollektorstrom von ca.  $10 \text{ mA}$  zu erwarten ist und die Simulation ein positives Gain liefert.

### 3.4 S-Parameter-Simulation

Schließlich wird die S-Parameter-Simulation durchgeführt. Diese ist wichtig, um einen angemessenen Gain bei der Übertragung zu gewährleisten. Die S-Parameter-Simulation wird in [ADS](#) nach folgenden Schritten durchgeführt:

1. Im ADS-Model wird die Kommentierung des S-Parameter-Controllers aufgehoben, also die S-Parameter-Einstellung wird aktiviert.
2. Da jetzt die DC-Simulation überflüssig ist, wird diese deaktiviert.

3. Vor der Simulation wird die Schrittweite des S-Parameter-Controllers auf 250 MHz gesetzt, sodass man die Qualität des Frequenz-Sweeps verbessert. 
4. Nach der Simulation wird das Ergebnis in einem neuen Fenster angezeigt. Es ergibt sich der folgende Verlauf des Gains für verschiedene Frequenzen:

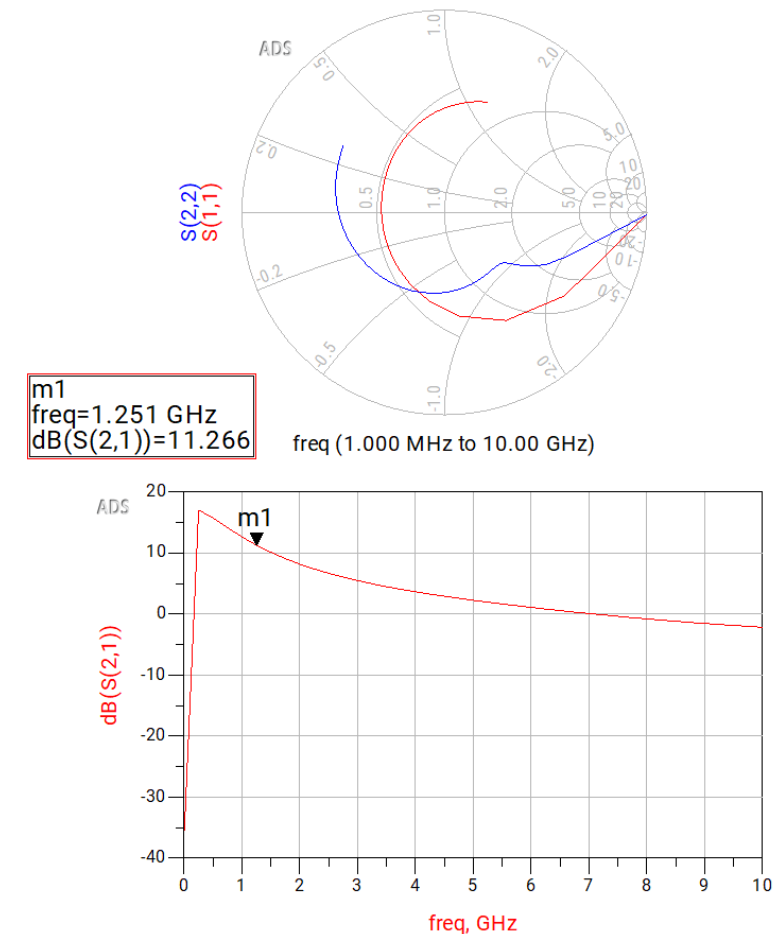



ABBILDUNG 3.3: Ergebnisse der S-Parameter-Simulation.

Hier wählt man die Schaltfläche “Insert A New Marker” aus . Wir setzen den Marker auf den Punkt unserer Arbeitsfrequenz, also bei 1,25 GHz (s. Abbildung 3.3). Der Marker m1 zeigt eine **Verstärkung (Gain) von 11,266 dB** an.

### 3.5 Fazit

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass die Simulation der Hochfrequenzschaltung mit ADS erfolgreich durchgeführt wurde. Die Dimensionierung der Widerstände wurde erfolgreich durchgeführt, um einen stabilen Arbeitspunkt zu erreichen. Auch die S-Parameter-Simulation zeigte ein positives Gain von 11,266 dB bei einer Frequenz von

1,25 GHz. Die Ergebnisse der Simulation stimmen mit den theoretischen Berechnungen überein. Die Software [ADS](#) erwies sich als nützliches Werkzeug zur Analyse und Simulation von Hochfrequenzschaltungen.

## Kapitel 4

# Technische Umsetzung(Erik)

### 4.1 Platinen Aufbau

### 4.2 DC-Pegel Verifizieren

### 4.3 Kalibrierung

### 4.4 Vergleich zur Simulation

adkafdkadfasdkl

## Kapitel 5

# Diskussion der Ergebnisse(GangBang)

### 5.1 Vergleich von Theorie und Praxis

### 5.2 Erklärung von Abweichungen

bla bla



# Kapitel 6

## Fazit(Jeder)

6.1 Zusammenfassung der wichtigsten Erkenntnisse

6.2 Reflexion und mögliche Verbesserungen

6.3 Eigene Reflexion

6.3.1 Erik

6.3.2 Farhad

6.3.3 Lukas

bla bla

# Literaturverzeichnis

- [1] Infineon Technologies AG: *BFR181W Silicon NPN RF Transistor*, Datenblatt, 2017. Online verfügbar unter: [https://www.infineon.com/dgdl/Infineon-BFR181W-DS-v02\\_00-en.pdf](https://www.infineon.com/dgdl/Infineon-BFR181W-DS-v02_00-en.pdf)
- [2] <https://www.atecorp.com/solutions/what-is-an-rf-amplifier> (zugegriffen am 17.04.2025)
- [3] [https://de.wikipedia.org/wiki/Verst%C3%A4rker\\_\(Elektrotechnik\)](https://de.wikipedia.org/wiki/Verst%C3%A4rker_(Elektrotechnik)) (zugegriffen am 17.04.2025)